



晶体管 TRANSISTOR 2N5551A

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I _c	600mA
V _{CEO}	160V
P _c	625mW

产品特性 FEATURES

硅外延	Epitaxial silicon
高开关速度	High switching speed
与 2N5401A 互补	Complementary to 2N5401A
RoHS 产品	RoHS product

用途 APPLICATIONS

高频开关电源	High frequency switch power supply
一般功率放大电路	Commonly power amplifier circuit
高频功率变换	High frequency power transform

封装形式 Package



TO-92

1. Emitter 2. Base 3. Collector

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (T_c=25°C)

项目 Parameter	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit
集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage (I _E =0)	V _{CB0}	180	V
集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage (I _B =0)	V _{CEO}	160	V
发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage (I _C =0)	V _{EB0}	6.0	V
最大集电极直流电流 Collector Current (DC)	I _c	600	mA
最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92)	P _c	625	mW
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	°C
贮存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-55~+150	°C

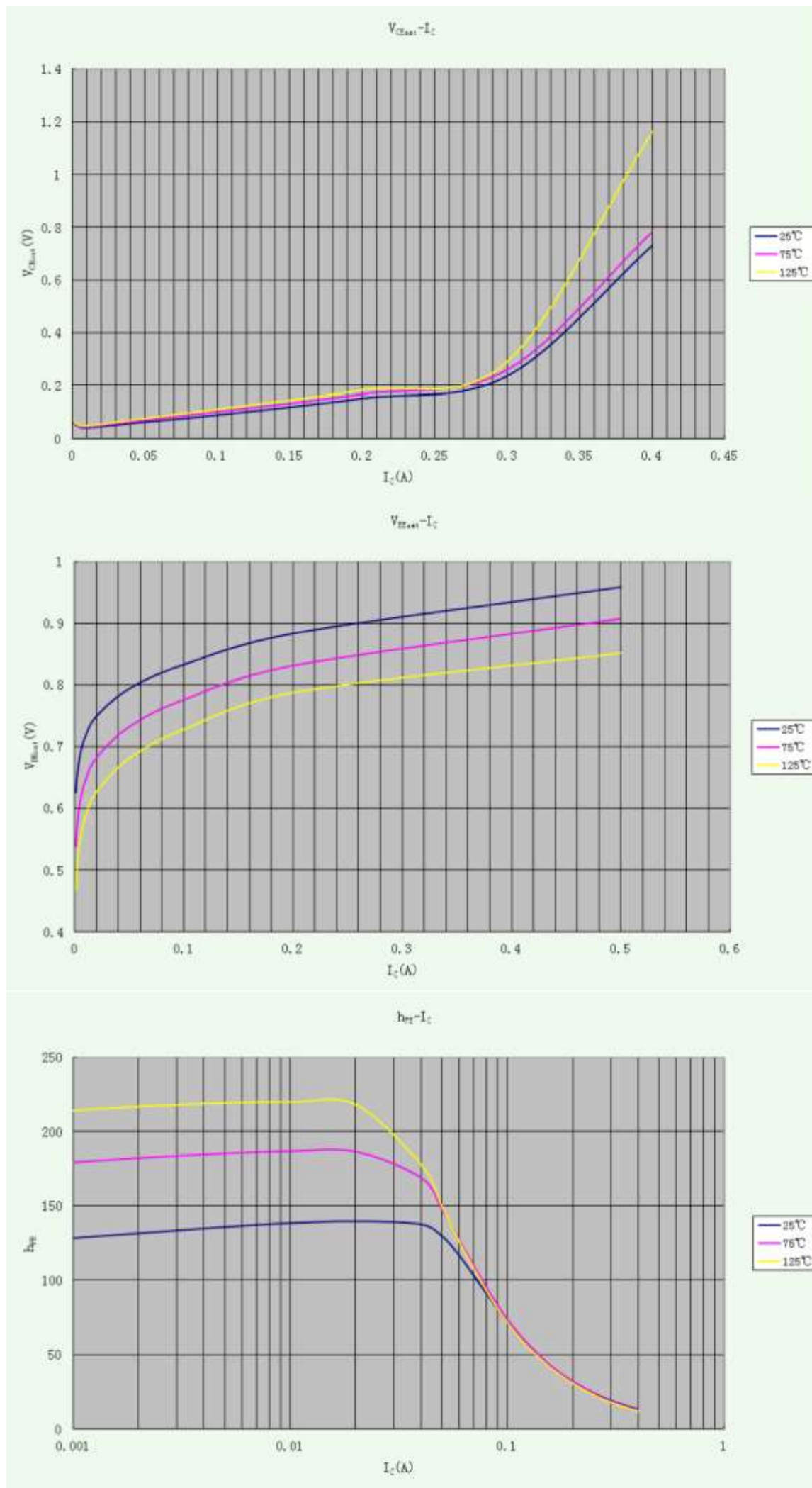
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 (min)	典型值 (typ)	最大值 (max)	单位 Unit
V(BR) _{CBO}	I _C =10μA, I _E =0	180	-	-	V
V(BR) _{CEO}	I _C =1.0mA, I _B =0	160	-	-	V
V(BR) _{EBO}	I _E =10μA, I _C =0	6.0	-	-	V
I _{CBO}	V _{CB} =180V, I _E =0	-	-	0.1	μA
I _{EBO}	V _{BE} =6V, I _C =0	-	-	0.1	μA
hFE (1)	V _{CE} =5V, I _C =10mA	100	-	300	-
hFE (2)	V _{CE} =5V, I _C =50mA	20	-	-	-
hFE (3)	V _{CE} =5V, I _C =1.0mA	40	-	-	-
V _{CE(sat)}	I _C =10mA, I _B =1.0mA	-	0.06	0.15	V
V _{CE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5.0mA	-	0.09	0.3	V
V _{BE(sat)}	I _C =10mA, I _B =1.0mA	-	0.7	1.0	V
V _{BE(sat)}	I _C =50mA, I _B =5.0mA	-	0.8	1.0	V
f _T	V _{CE} =10V, I _C =10mA	50	110	-	MHz

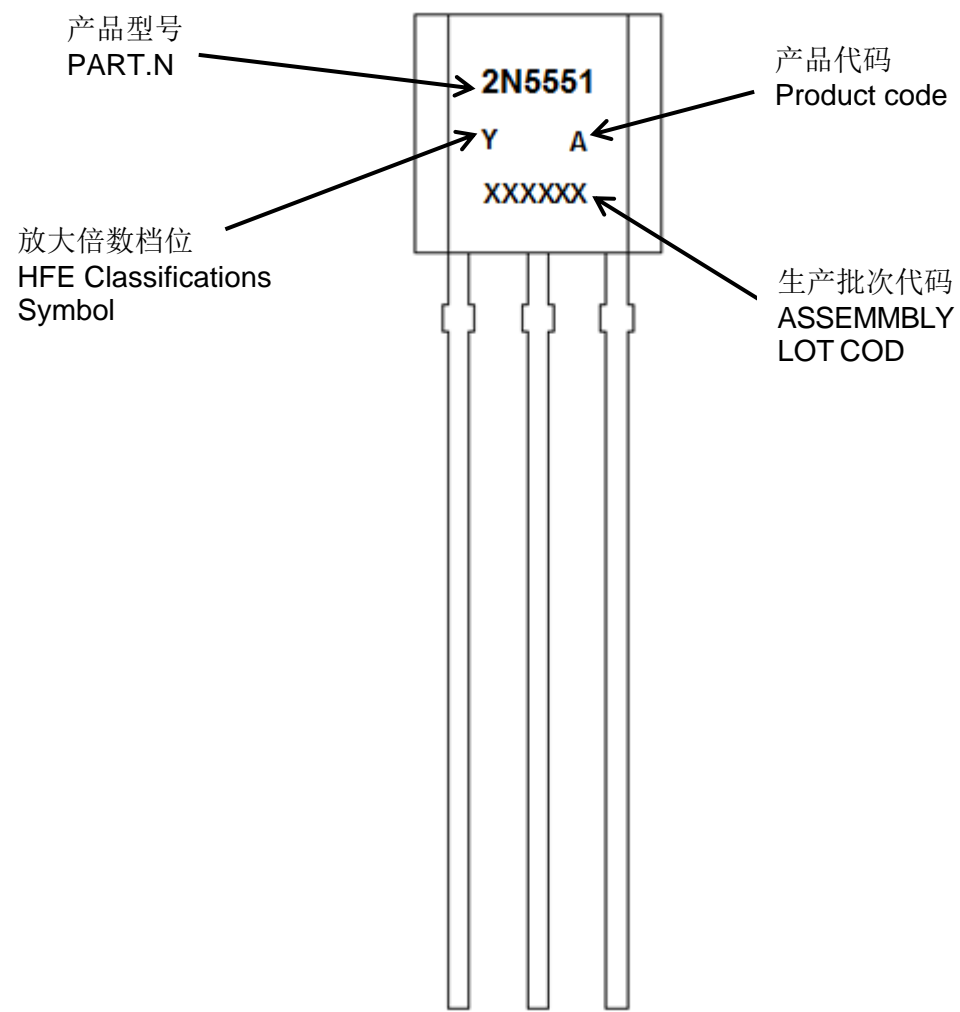
放大倍数 hFE Classifications

hFE Classifications Symbol	Y1	Y2
hFE Range	100-200	200-300

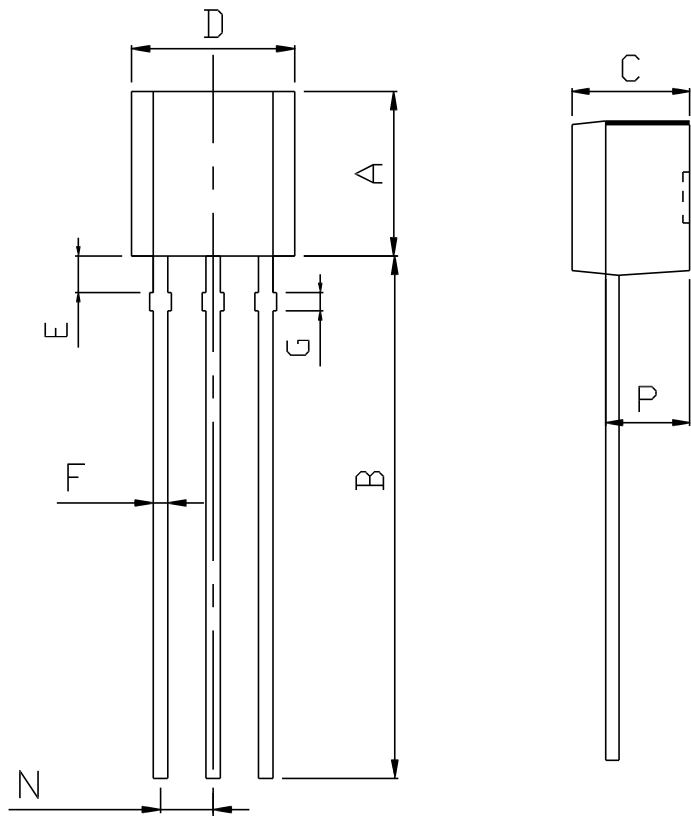
典型特性曲线 Electrical Characteristics



印记 Marking:



外形尺寸: Package Dimension



DIM	MILLIMETERS
A	4.55+0.20
B	14.50±0.30
C	3.54±0.20
D	4.56±0.20
E	1.30±0.20
F	0.46±0.20
G	0.50±0.10
H	0.32±0.10
N	1.30±0.20
P	2.52±0.20

(Units: mm)

